
2026年12月期 第2四半期（中間期）決算説明会

2026年8月10日（月）



証券CODE:4971

<https://www.mec-co.com/>

1

売上： 12,594百万円（前年同期比 34.2%増加）
営業利益： 4,135百万円（前年同期比 69.4%増加）

2

為替の影響は前年同期比

売上： 777百万円増加、営業利益： 472百万円増加

3

薬品売上： 12,402百万円（前年同期比 37.4%増加）
出荷量： 26,798ton （前年同期比 21.9%増加）

4

主要製品売上は前年同期比

EXE 44.8%増加、CZ 37.1%増加、V-Bond 16.3%増加、SF 6.4%減少

(単位：円)

	期初想定	2026 1H	2025 1H	2026 1Q
N T D	4.95	5.01	4.68	4.96
R M B	21.24	23.02	20.53	22.58
T H B	4.67	4.91	4.44	4.93
E U R	175.76	184.70	162.60	183.65
U S D	151.02	158.28	148.98	156.45

- 海外現地法人は、基本的に現地通貨建てでの取引であり、連結会計で円換算する際に、円／現地通貨レートの影響を受ける
- いずれも、期中平均レートを採用
- 当社の主要外国通貨は、台湾ドル（NTD）および中国人民元（RMB）
- 各通貨に対して想定レートから0.1円変動する場合の影響額は次のとおり
 NTD：（売上高）46百万円（営業利益）35百万円
 RMB：（売上高）17百万円（営業利益）11百万円
 ＊いずれも、1H実績

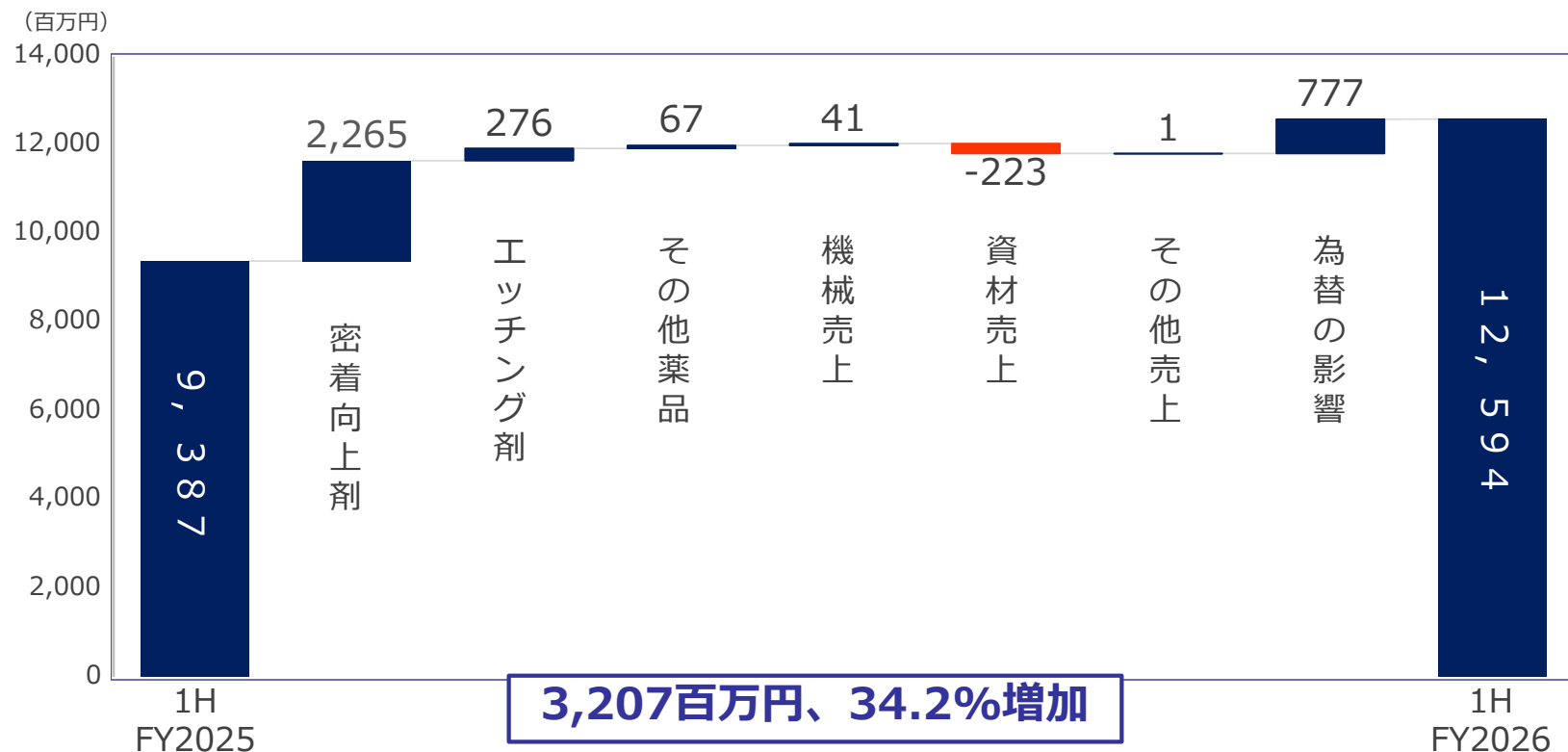
2026年12月期 第2四半期（中間期）業績概要



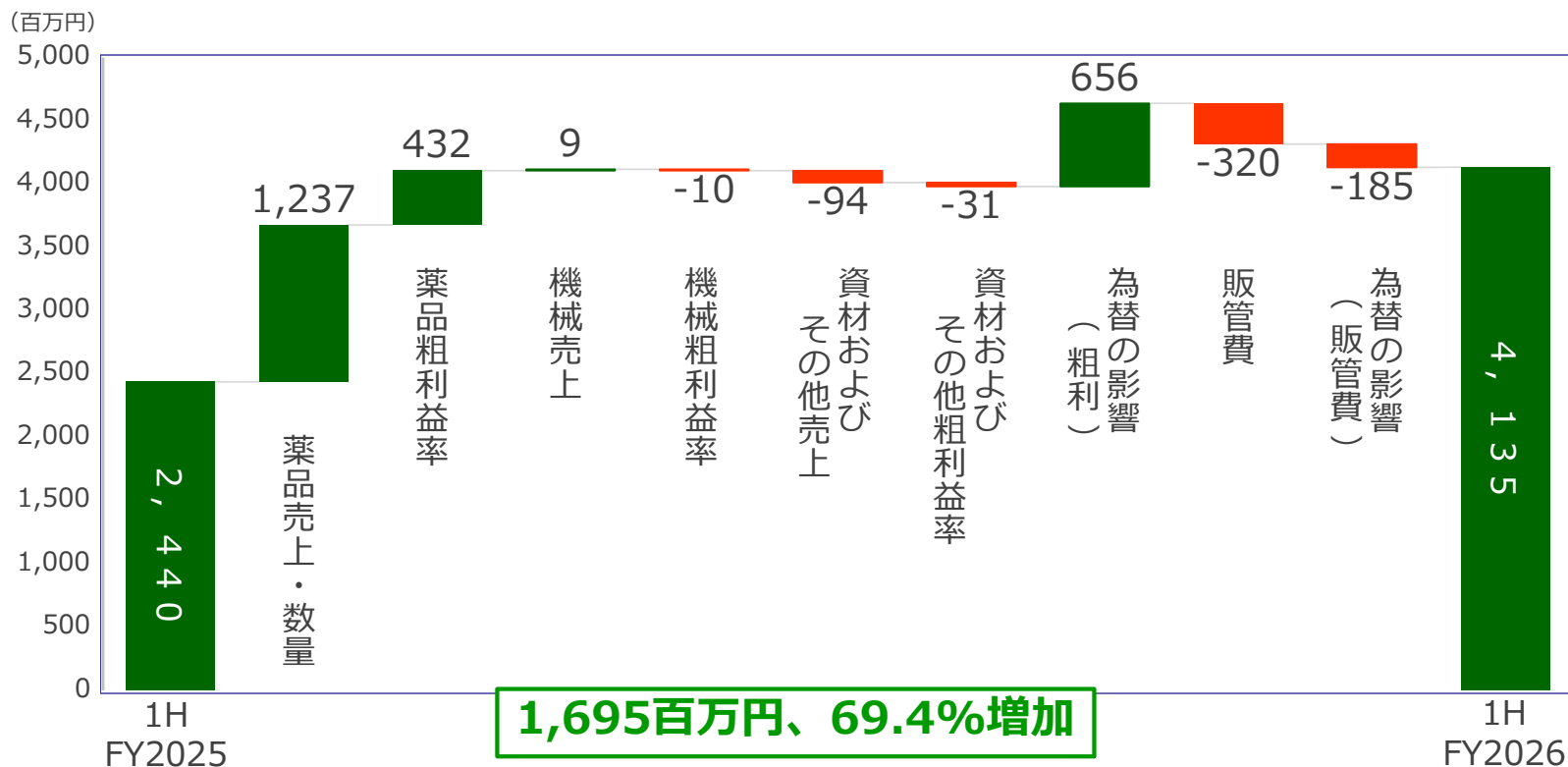
（単位：百万円）

	第2四半期（中間期）						通期		
	FY25.12 1H		FY26.12 1H				FY25.12	FY26.12	
	（実績）	進捗率	（実績）	進捗率	前年同期比		（実績）	（予想）	前期比
売上高	9,387	44.8%	12,594	48.8%	3,207	34.2%	20,947	25,800	23.2%
薬品売上高	9,025	-	12,402	-	3,376	37.4%	20,211	-	-
売上総利益	5,804	-	8,004	-	2,200	37.9%	12,977	-	-
売上総利益率	61.8%	-	63.6%	-	-	-	62.0%	-	-
販売費及び一般管理費	3,363	-	3,868	-	505	15.0%	7,229	-	-
売上高比率	35.8%	-	30.7%	-	-	-	34.5%	-	-
営業利益	2,440	42.5%	4,135	49.8%	1,695	69.4%	5,748	8,300	44.4%
営業利益率	26.0%	-	32.8%	-	-	-	27.4%	32.2%	-
経常利益	2,493	41.2%	4,305	50.7%	1,811	72.6%	6,051	8,500	40.5%
経常利益率	26.6%	-	34.2%	-	-	-	28.9%	32.9%	-
税引前中間(当期)純利益	2,892	-	4,300	-	1,407	48.7%	6,473	-	-
中間(当期)純利益	1,893	37.7%	3,039	50.7%	1,145	60.5%	5,028	6,000	19.3%
EBITDA	3,287	-	4,731	-	1,444	43.9%	7,302	-	-
1株当たり中間純利益（円）	101.47	-	166.43	-	-	-	272.14	328.58	-
1株当たり配当金（円）	25.00	-	55.00	-	-	-	96.00	110.00	-
ROE	7.0%	-	9.1%	-	-	-	17.5%	17.5%	-

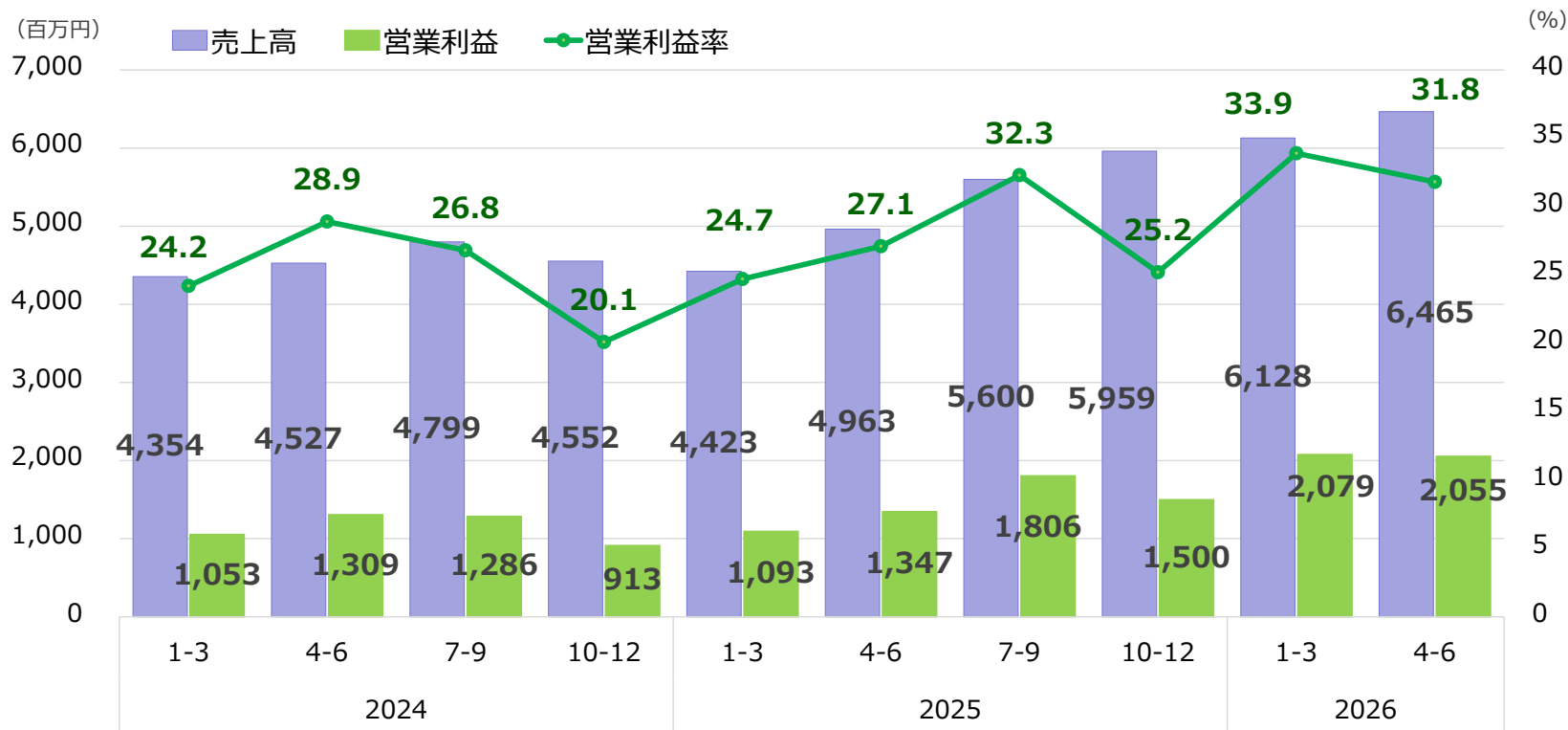
連結売上高前年同期比分析



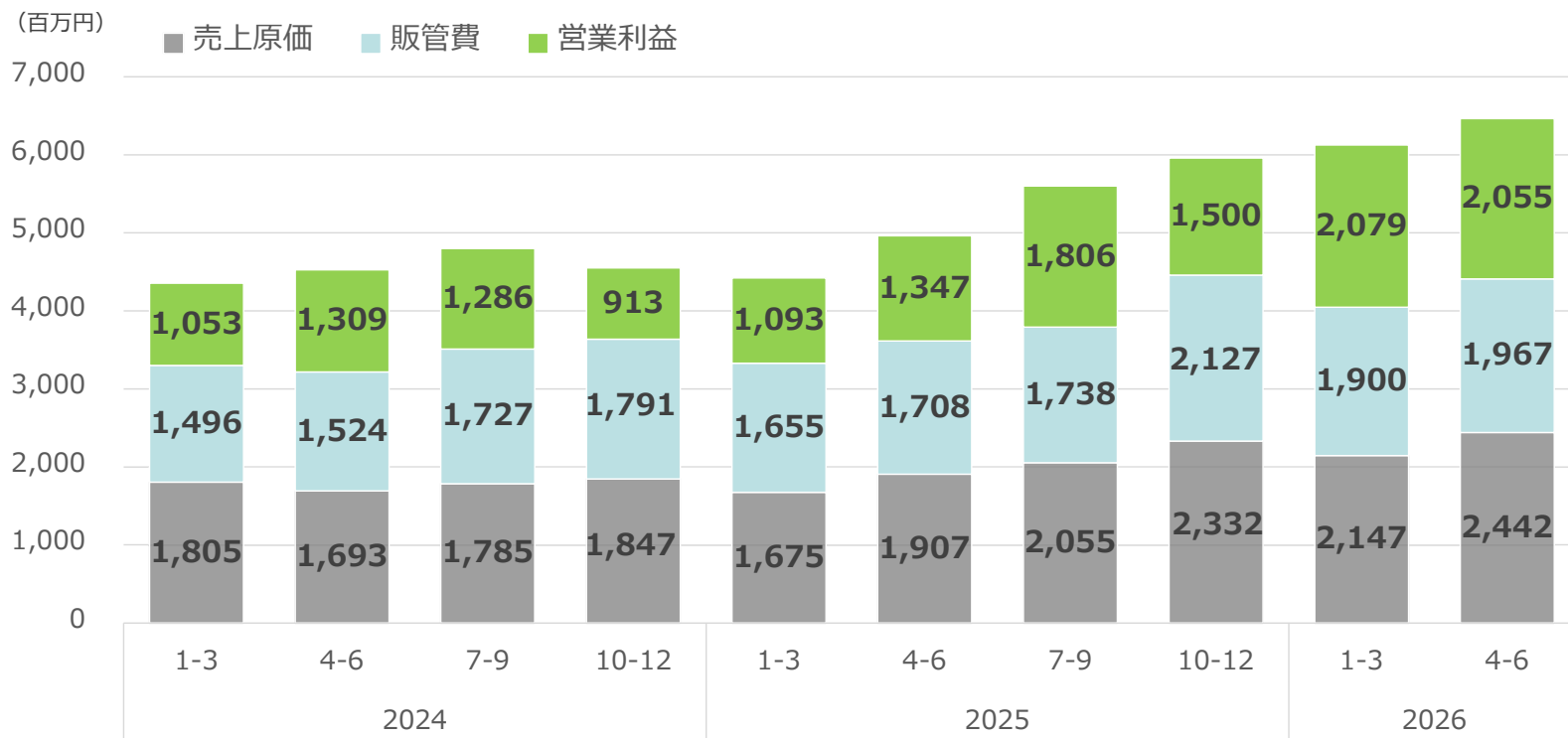
連結営業利益前年同期比分析



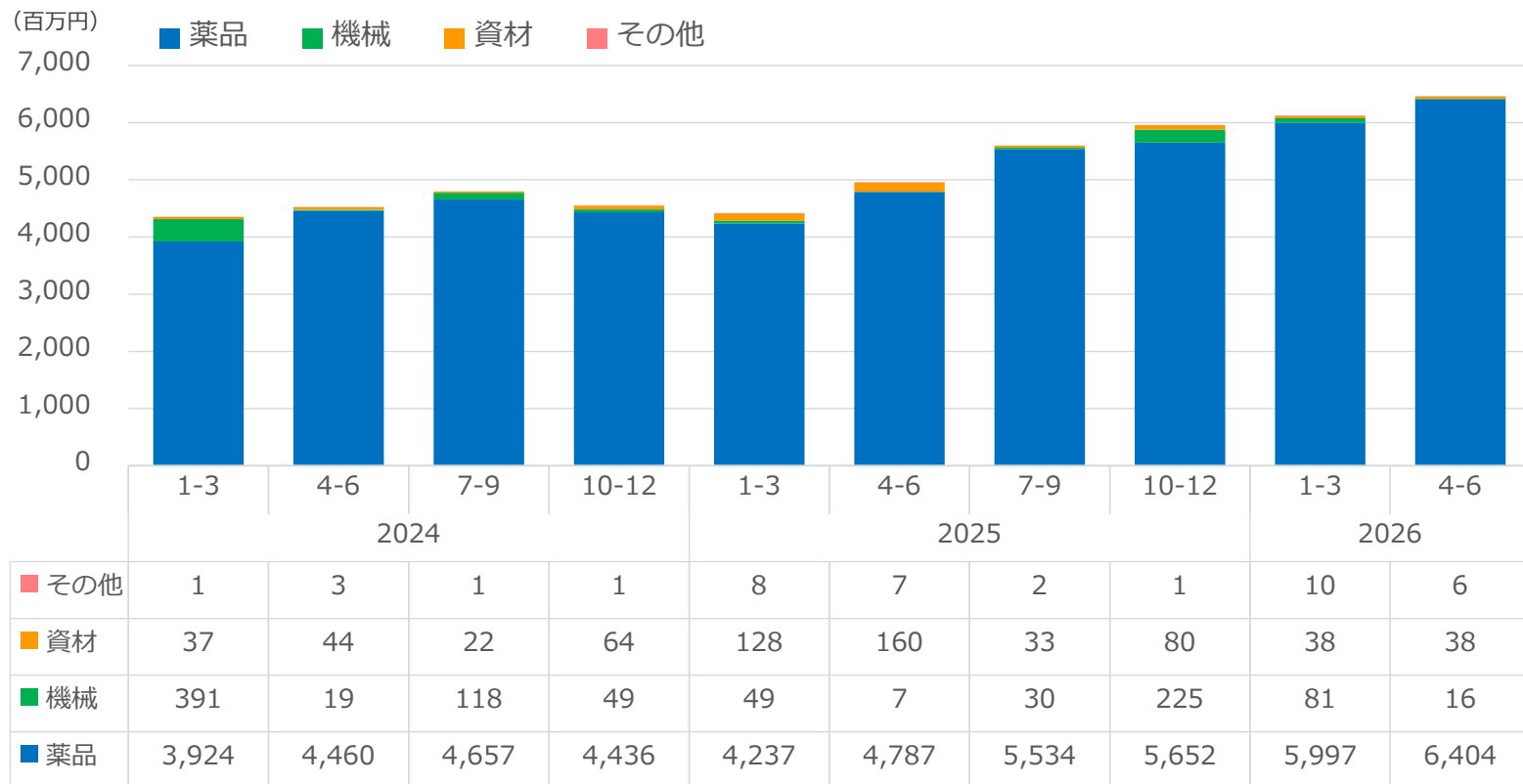
連結売上高と営業利益/営業利益率



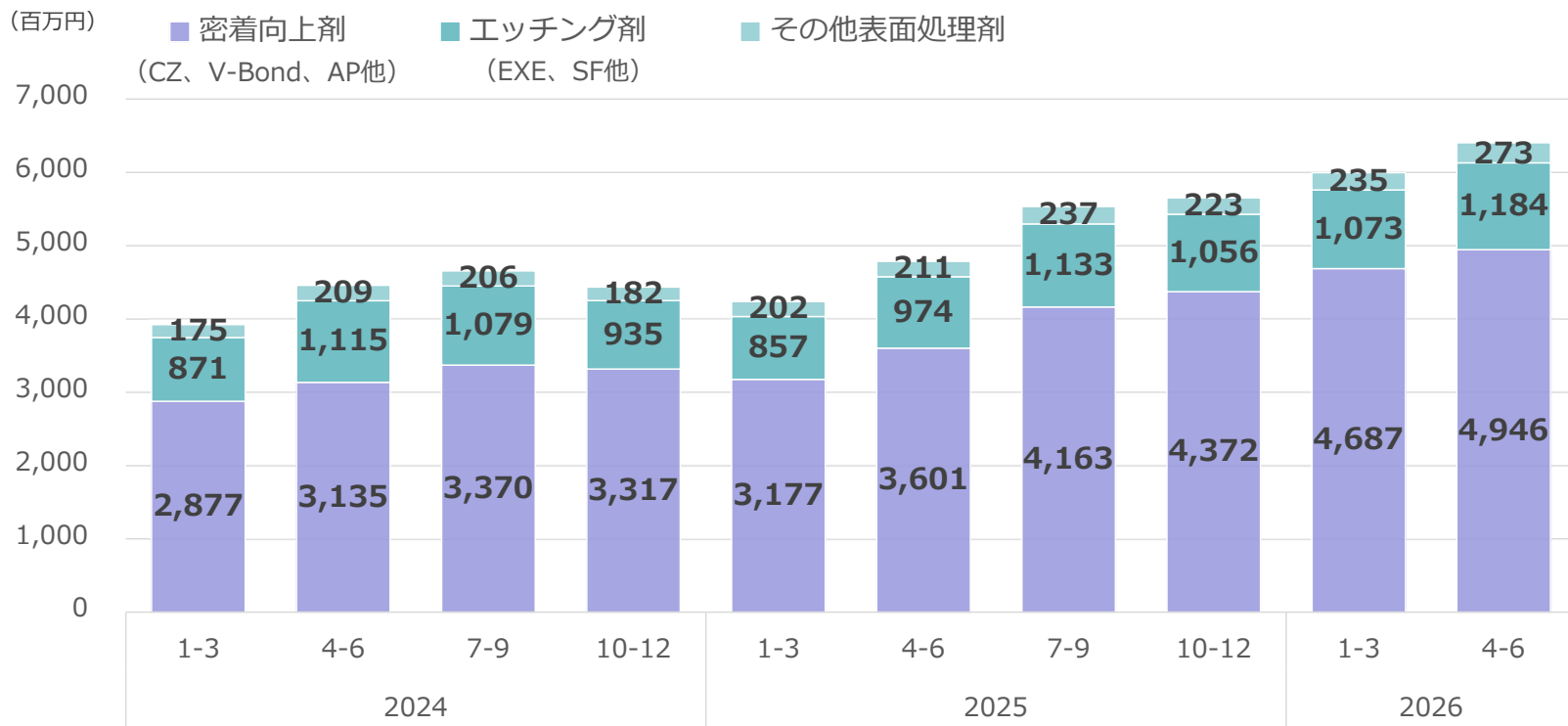
連結損益構造



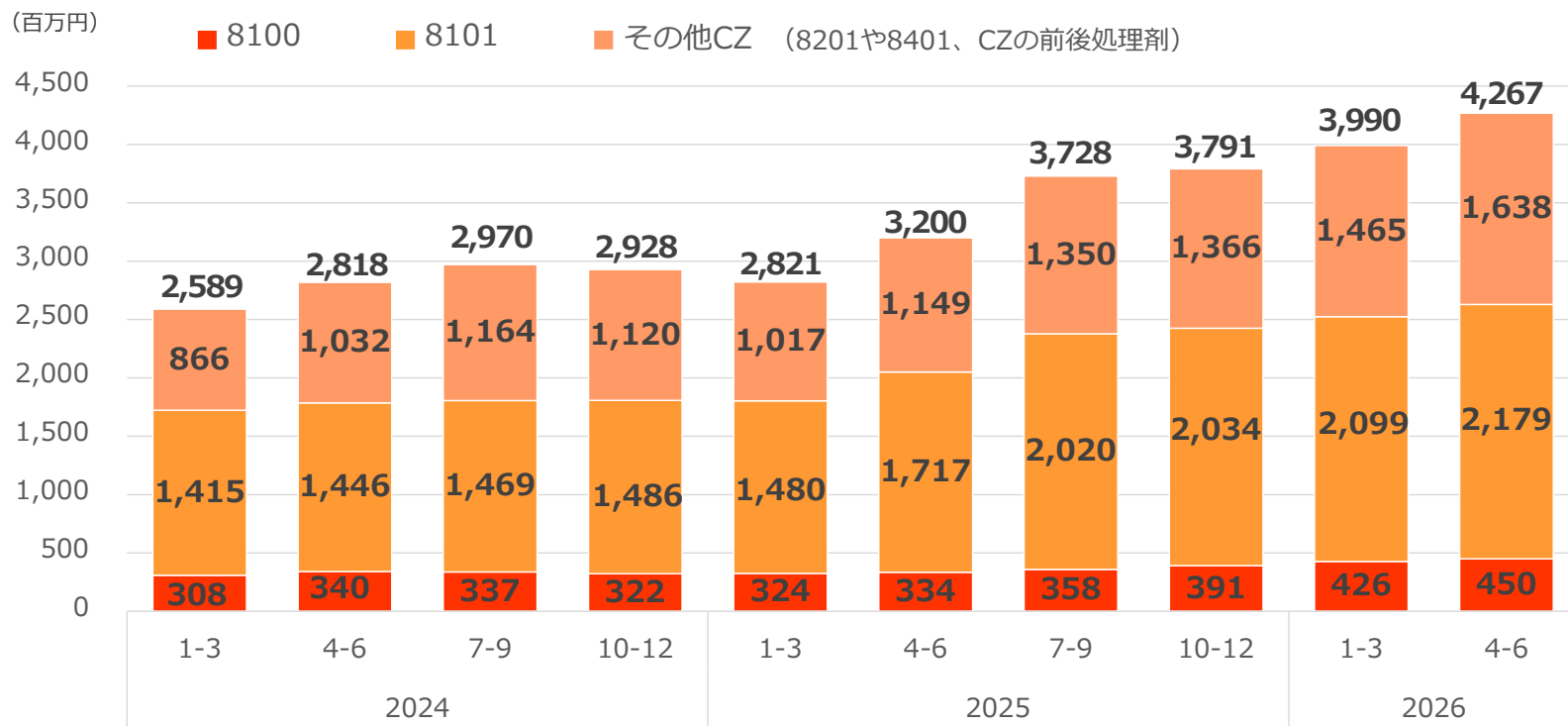
連結品種別売上高



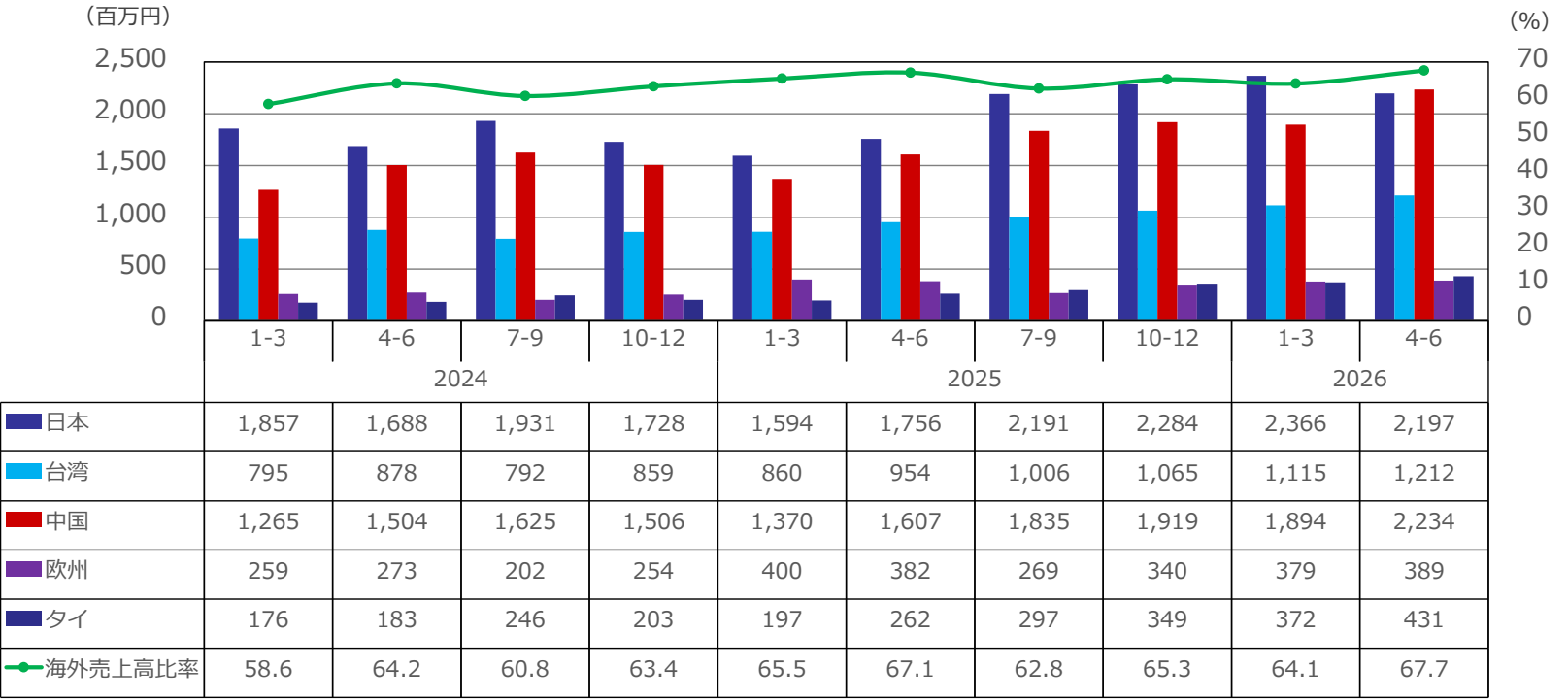
連結薬品別売上高



CZシリーズ売上高



地域セグメント別売上高



・日本国内代理店経由で販売した海外顧客への売上を海外売上高比率に含めた場合の比率は、82.7%（前年同一期間は、81.2%）。

今後の見通し

事業環境

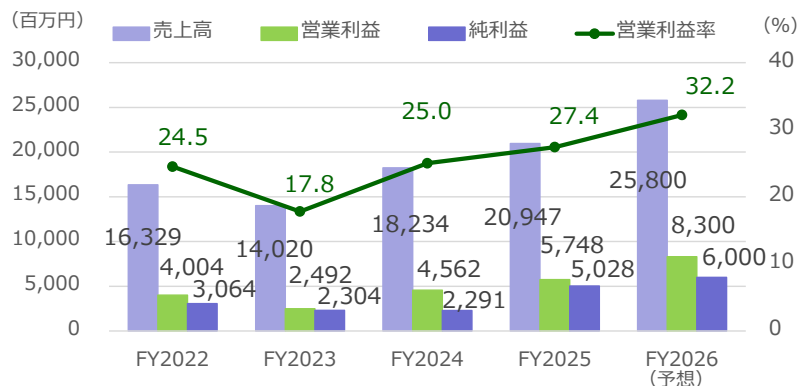
- ・中長期的には、IoTやAI、5G/6G、クルマの電動化・自動化・コネクテッド化やDX・GXの進展等、デジタル革命の進展に伴い技術革新が進む。
これら技術の広がり背景に、当社関連市場の拡大を見込む。
- ・特に高まる半導体需要による半導体PKG基板の増加、超高密度化や超高周波化により、関連する「CZシリーズ」、「化学密着向上剤」需要の伸びを見込む。

主要製品

- CZ : 短期的には半導体市況の影響を受ける。
中長期的には半導体PKG基板の増加、大型・高多層化等により需要拡大を見込む。
- V-Bond : 衛星通信基板向け増加基調。クルマやスマートフォン市況の影響を受ける。
- EXE : ディスプレイ需要の影響を受ける。
微細配線形成のニーズによりディスプレイ向け用途以外での需要増加を見込む。
- SF : タブレットPC需要の影響を受ける。

2026年12月期 連結業績予想

	FY2025		FY2026(8/10発表)		
	百万円	利益率(%)	百万円	利益率 (%)	増減率
売上高	20,947	-	25,800	-	23.2
営業利益	5,748	27.4	8,300	32.2	44.4
経常利益	6,051	28.9	8,500	32.9	40.5
純利益	5,028	24.0	6,000	23.3	19.3
1株当たり純利益(円)	272.14	-	328.58	-	-

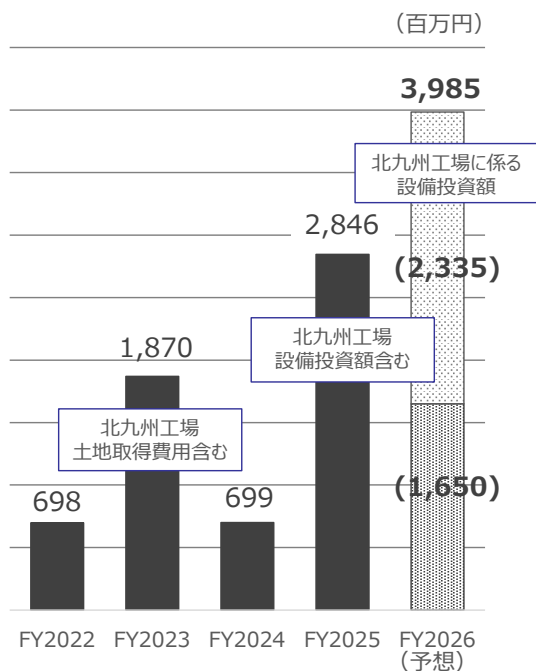


為替レート

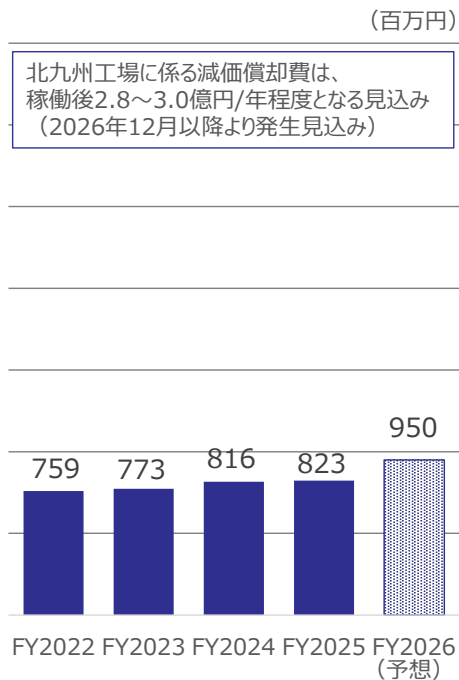
	FY2025 (実績)	FY2026 (想定)
N T D	4.81	4.96
R M B	20.94	22.58
T H B	4.57	4.93
E U R	169.14	183.65
U S D	150.40	156.45

設備投資額と減価償却費、研究開発費

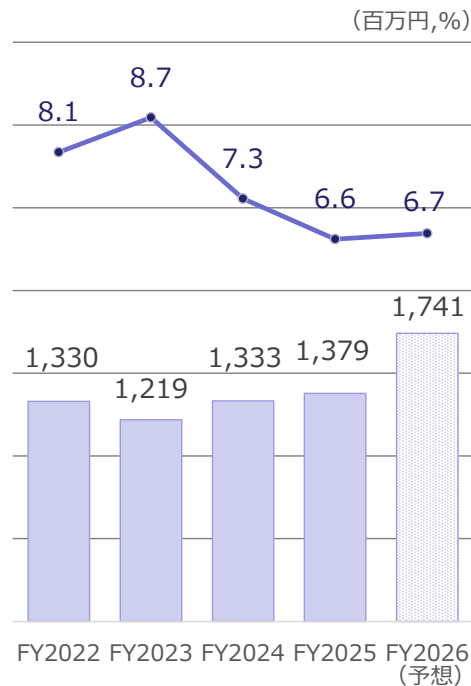
設備投資額



減価償却費

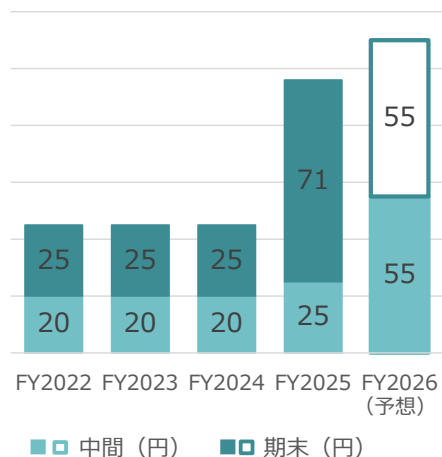


研究開発費と 売上高研究開発費比率

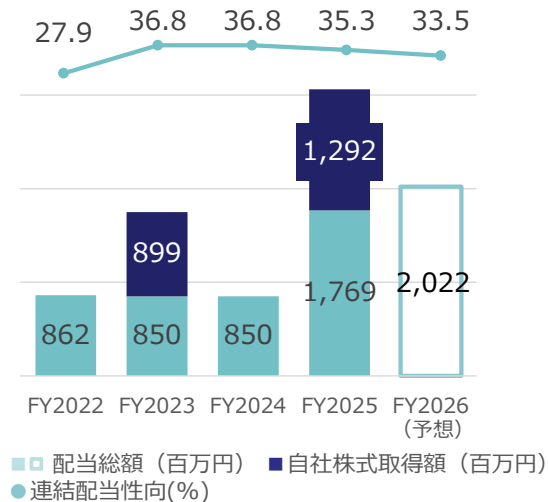


配当金と連結配当性向、ROEの推移

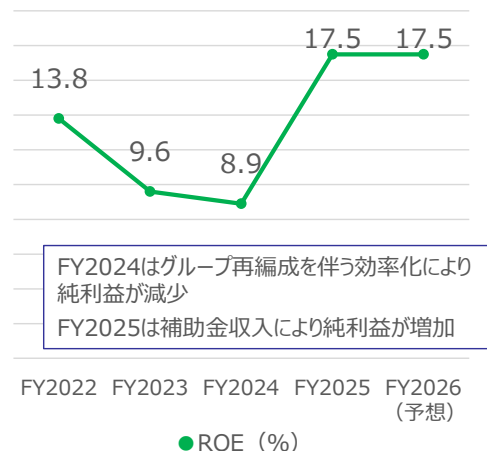
1株当たり配当金



配当総額/自己株式取得額/連結配当性向



ROE



【株主還元方針】

- ・ 連結配当性向35%以上かつDOE 4.0%以上
- ・ 自己株式取得は状況に応じ機動的に実施

【ROE目標】 13～16%

キャッシュ・アロケーション 基本方針

Phase 2（2025～2027年累計）キャッシュ・アロケーションの基本方針。

経営資本を投入し事業活動により得た利益は、バランスを見ながら株主還元や成長投資、基盤強化に配分します。

キャッシュイン・手元資金 (3年間累計の計画)



キャッシュアウト (3年間累計の計画)



投資の配分	
● 設備成長投資	4,000百万円
● 設備維持更新投資	4,000百万円
● 技術サポート・マーケティング体制の強化	金額は適宜判断
● M&A	
● 研究開発	5,200百万円
● 配当金	5,300～5,400百万円 機動的に実施 (2025年 1,292百万円自己株式取得済)
● 自己株式取得	

※各項目の大きさはその額の大きさを示すものではありません。 2026年12月期 第2四半期（中間期）決算説明会資料

Environment

- 環境負荷低減製品の開発
- 適正な化学物質管理
- 資源循環の推進
- 気候関連問題への対応

Social

- 人的資本戦略
- 多様な人財の活用（女性活躍、WLB、男性の育休取得推進等）
- 産業発展への貢献（高速通信整備、自動運転、AI、DX、GX等）

Governance

- 経営基盤の強化（CG体制、リスクマネジメント、コンプライアンスの徹底等）

超高密度
超高周波



最先端品 化学密着向上剤APシリーズ



先端品 CZ-8401
×化学密着向上剤APシリーズ
CZ-8201



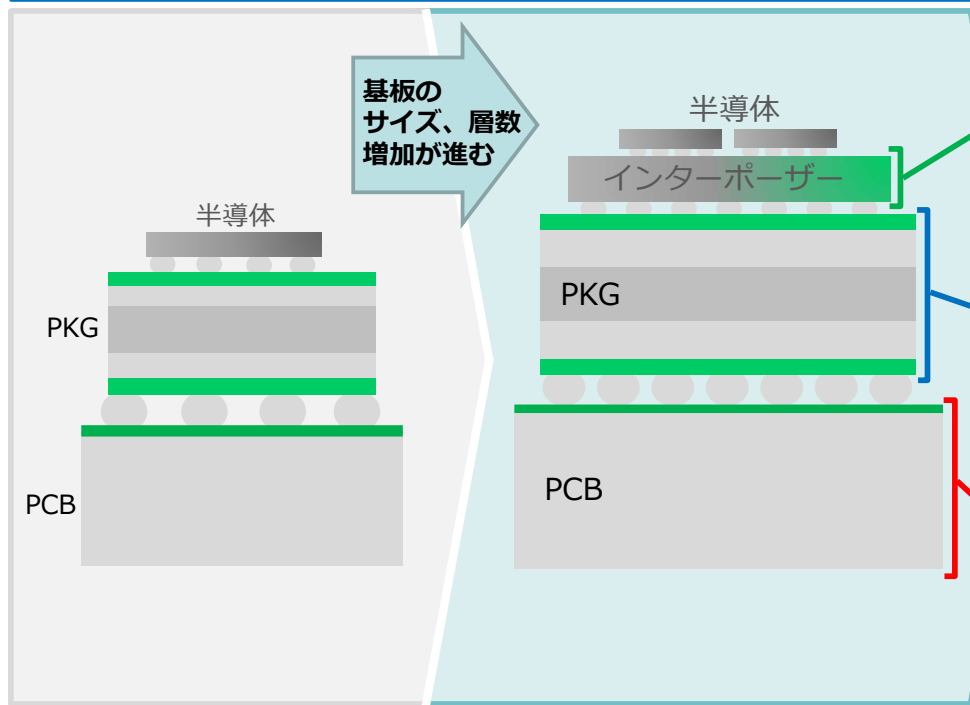
汎用品 CZ-8101
CZ-8100



技術領域の拡大を目指して

当社技術の進化と求められる技術

超高密度化、信号低損失、低消費電力



新領域（インターポザー）

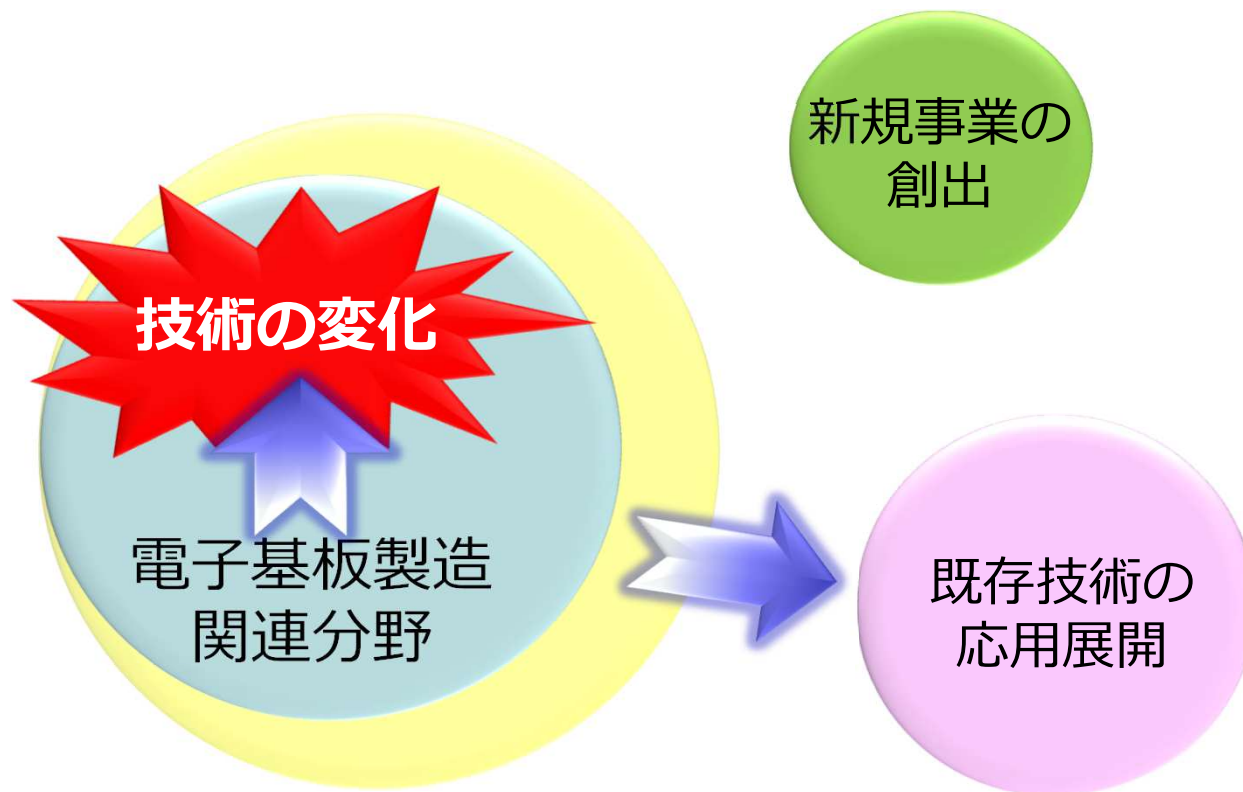
- ・適用製品：粗化密着処理（CZ）×化学密着処理（AP）
- ・技術動向：超高密度化（低L/S）
- ・想定する最終製品例：生成AI関連、データセンター

既存領域（PKG基板）

- ・適用製品：粗化密着処理（CZ）、化学密着処理（AP）
- ・技術動向：高密度化（低L/S）
低消費電力のニーズによる粗化量低減
- ・想定する最終製品例：生成AI関連、データセンター

新領域（高周波基板）

- ・適用製品：化学密着処理（AP）
- ・技術動向：信号低損失のニーズによる粗化量低減
- ・想定する最終製品例：生成AI関連、データセンター
半導体検査機



参考資料

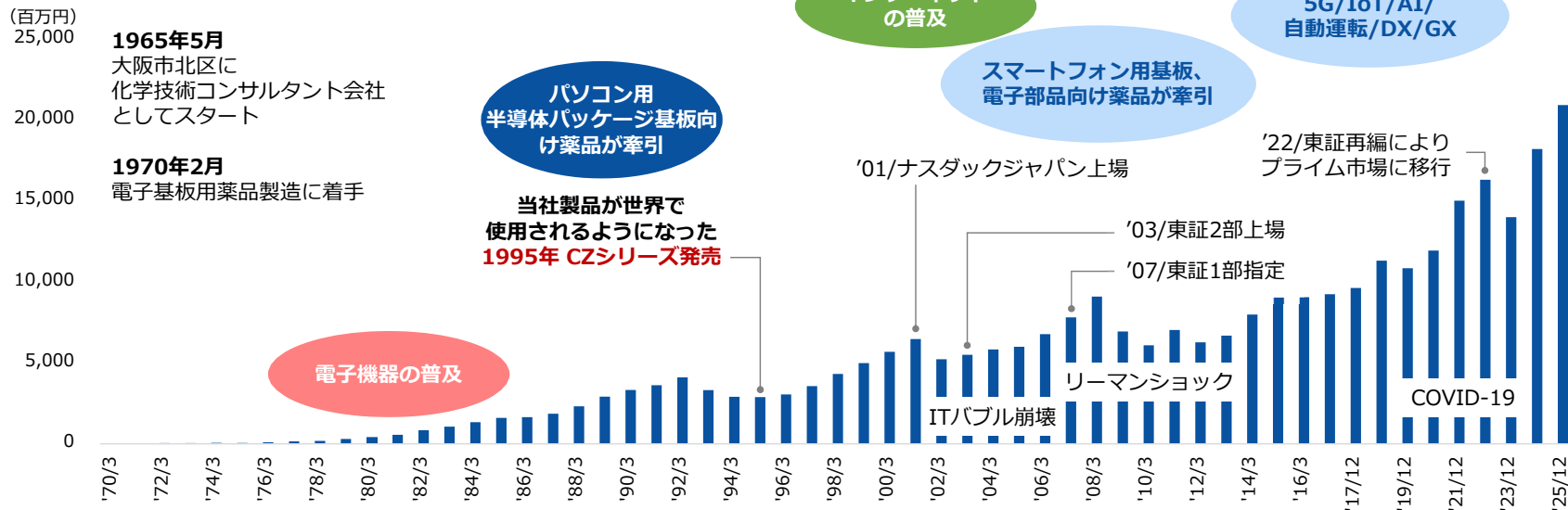
(2025年12月31日現在)

社 名	メック株式会社 MEC COMPANY LTD.
本 社 所 在 地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
設 立 年 月 日	1969（昭和44）年5月1日
主 な 業 務 内 容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造販売 及び 機械装置、各種資材の販売
代 表 者	代表取締役社長 前田 和夫
資 本 金	5億9,414万2,400円
連 結 売 上 高	209億47百万円
上 場 市 場	東証プライム市場（4971／化学セクター）
従 業 員 数	連結508名、単体292名

主に個人用端末で電子基板を使用

電子基板の用途が
社会インフラに拡大

売上高の推移



※2017年12月期（第49期）は、決算期変更により2017/4/1～12/31までの9カ月。なお、連結対象期間については、当社は9カ月間（2017/4/1～12/31）、連結子会社は12カ月間（2017/1/1～12/31）。



研究所から
工場へ

テーマ決定 ⇒ ビーカー実験 ⇒ スケールアップ実験 ⇒ 応用ライン検証



お客様へ



製造 ⇒ 品質検査 ⇒ 充填

≪乾燥処理≫



≪水洗処理≫



≪薬液処理≫



基板受取



基板投入

界面価値創造

- 表面を粗化し、
機械的に密着性を向上

CZ、V-Bond



- 配線を形成する

EXE



- 選択エッチング

SF



- 表面を処理し、
化学的に密着性を向上

AP



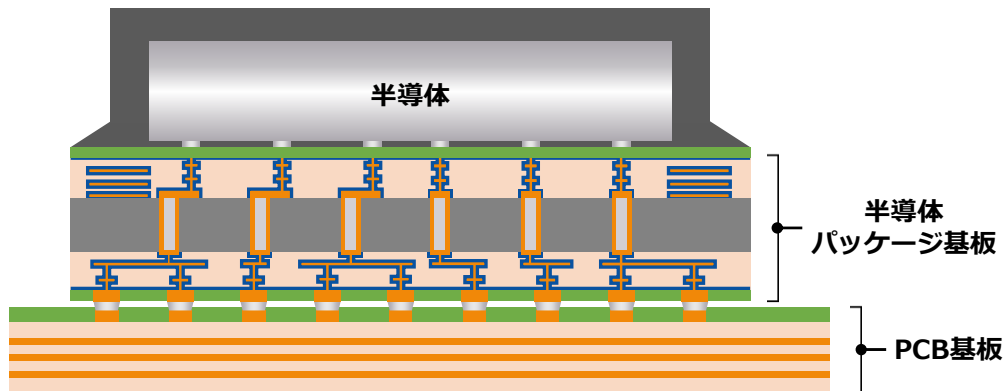
主要薬品用途と最終製品例

主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める 銅表面処理剤。 主にPKG基板向けの密着向上剤で、 高密度PCBにも使用される。	生成AI関連、5G/6G関連・ データセンター等のインフラ、 パソコン・スマートフォン・ タブレットPC等の高機能デバ イス等
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める 銅表面処理剤。 多層基板向けの密着向上剤で、 PKG基板には使用されない。	クルマ、スマートフォン、 衛星通信等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	サブトラで微細配線形成ができる。 主にCOF基板向けのエッチング剤と して使用される。	テレビ・パソコンの モニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

当社の強み 層間密着技術



主力製品「CZシリーズ」は、銅と樹脂との密着が求められる界面で貢献しています。
半導体パッケージ基板の銅とビルドアップ樹脂との密着向上プロセスで欠かせない技術です。



■ CZシリーズが使用される場所

■ 銅

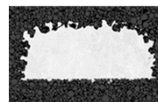
■ ソルダーレジストインク

■ 樹脂

半導体パッケージ基板が大型化・高多層化

⇒ CZシリーズの使用量増加

CZ-8101 1.0 μ m



微細に粗化

CZ-8201 0.5 μ m



極微細に粗化

CZ-8401 + APシリーズ
(0.1 μ m + 化学密着タイプ)



超微細に粗化 +
有機密着

開発中 0.0 μ m
(化学密着タイプ)



無粗化による
有機密着

より低エッチングに

銅表面密着技術の変遷

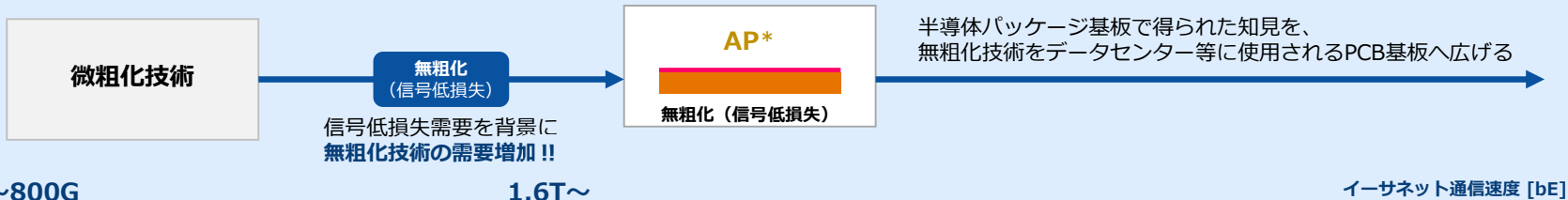
コア事業：半導体パッケージ基板



粗化技術および無粗化技術（化学密着）は需要増加

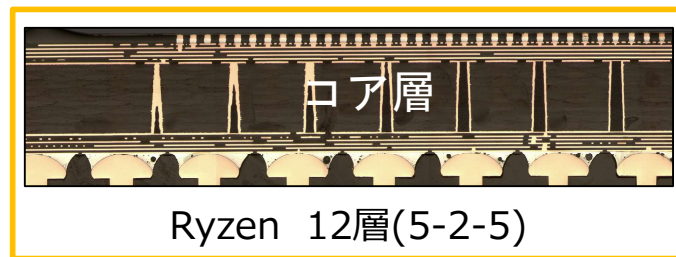
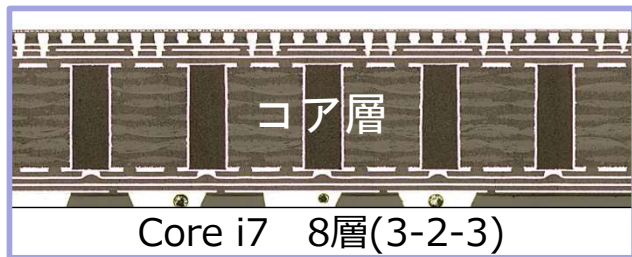
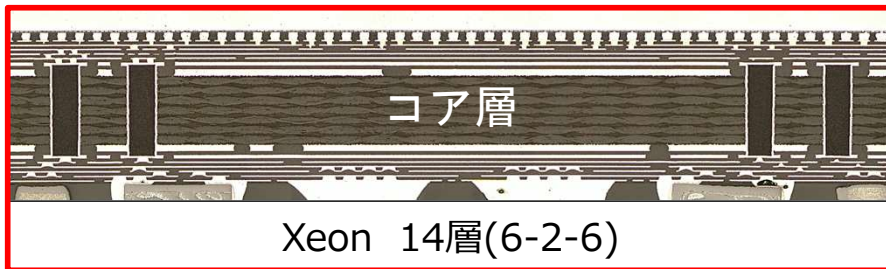
CZ-8101は関連市場の拡大に伴い需要増加
CZ-8201、8401はエッチング量低減需要(信号低損失需要)に伴い需要拡大
無粗化技術であるAPは採用に向けた評価の継続と技術の深化が進む
半導体パッケージ基板の他にも信号低損失の需要が明確化

応用展開：PCB基板（高周波基板）



* AP : Adhesion Promotor 無粗化技術による化学密着、微粗化に対する化学密着補強

半導体パッケージ (PKG) 基板の断面



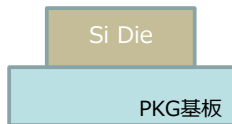
	PKG面積	層数
Xeon	27.44 cm ²	14
Core i7	14.44 cm ²	8
Ryzen	16.00 cm ²	12

*当社で入手、分解しました

半導体パッケージ（PKG）基板の進化

通常のPKG基板

一つのPKGに一つの半導体



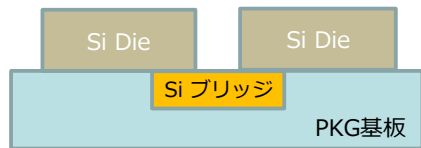
先端PKG基板（Chiplet、2.xDパッケージ）

PKGを大きくし複数の半導体を搭載

PKGの高密度化/サイズ大型化/高多層化

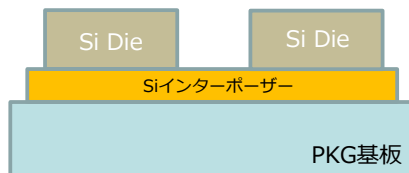
EMIB/EMIB-T

(Embedded **M**ulti-die **I**nterconnect **B**ridge)



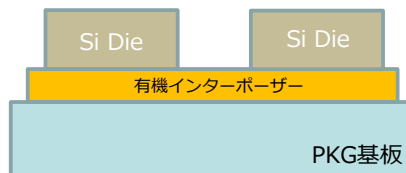
CoWoS-S

(Chip on Wafer on Substrate)



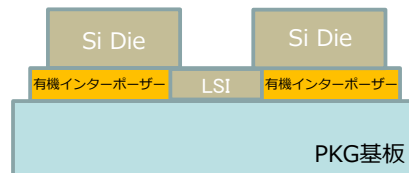
CoWoS-R

(Chip on Wafer on Substrate)



CoWoS-L

(Chip on Wafer on Substrate)



国内拠点



尼崎工場（少量多品種）
900 t /月



長岡工場（量産工場）
2,750 t /月

新拠点



北九州工場 イメージ
最大生産能力 2,500 t /月（予定）
2026年12月稼働（予定）

海外拠点



メック台湾
1,200 t /月



メック蘇州
1,350 t /月



メック珠海
1,000 t /月



メックヨーロッパ
400 t /月



メックタイ
500 t /月

2025年12月現在

※設備能力は設備スペック上の最大値です

界面価値創造

Creating and Fostering Value at Various Interfaces

このプレゼンテーション資料には、2026年8月10日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。

